

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 17 年 4 月 28 日 (2005.4.28)

【公表番号】特表 2004-512693(P2004-512693A)
 【公表日】平成 16 年 4 月 22 日 (2004.4.22)
 【年通号数】公開・登録公報 2004-016
 【出願番号】特願 2002-538478(P2002-538478)
 【国際特許分類第 7 版】

H 0 1 L 21/304

【F I】

H 0 1 L 21/304 6 5 1 B

H 0 1 L 21/304 6 2 2 Q

H 0 1 L 21/304 6 4 3 A

H 0 1 L 21/304 6 4 3 B

H 0 1 L 21/304 6 4 7 Z

H 0 1 L 21/304 6 5 1 G

H 0 1 L 21/304 6 5 1 L

【手続補正書】

【提出日】平成 15 年 7 月 8 日 (2003.7.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

化学的機械研磨工程後に行う半導体ウェハ表面の洗浄方法において、
 半導体ウェハを連続的に回転させている状態で、
殺菌された蒸留水によってすすぐ方法工程と、
H F 溶液によってエッチングする方法工程と、
殺菌された蒸留水によってすすぐ方法工程と、
イソプロパノールおよび窒素からなる混合気体によって乾燥させる方法工程と、
 を行う方法。

【請求項 2】

上記乾燥工程を行う間、半導体ウェハの回転速度を上げる、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

上記化学的機械研磨工程の後、かつ、洗浄方法の前に、半導体ウェハを水槽に貯蔵する、
請求項 1 または 2 に記載の方法。

【請求項 4】

請求項 1 ～ 3 のいずれかに記載の方法によって、化学的機械研磨工程の後、半導体ウェハ
の表面を洗浄するための装置であって、
半導体ウェハ用の着脱部と、半導体ウェハを支えて回転させるための回転盤と、半導体ウ
ェハを洗浄するためのプロセス溶媒の供給部と、半導体ウェハを洗浄するためのプロセス
溶媒の回収部とを備えた、プロセス室を有する装置。

【請求項 5】

上記プロセス室は、各洗浄工程を行うための独立したプロセス部を備え、プロセス部の間
で上記回転盤が移動できるように設計されている、請求項 4 に記載の装置。

【請求項 6】

上記プロセス室の着脱部を化学的機械研磨機に接続するためのウェットハンドルが備えられている、請求項 4 または 5 に記載の装置。